



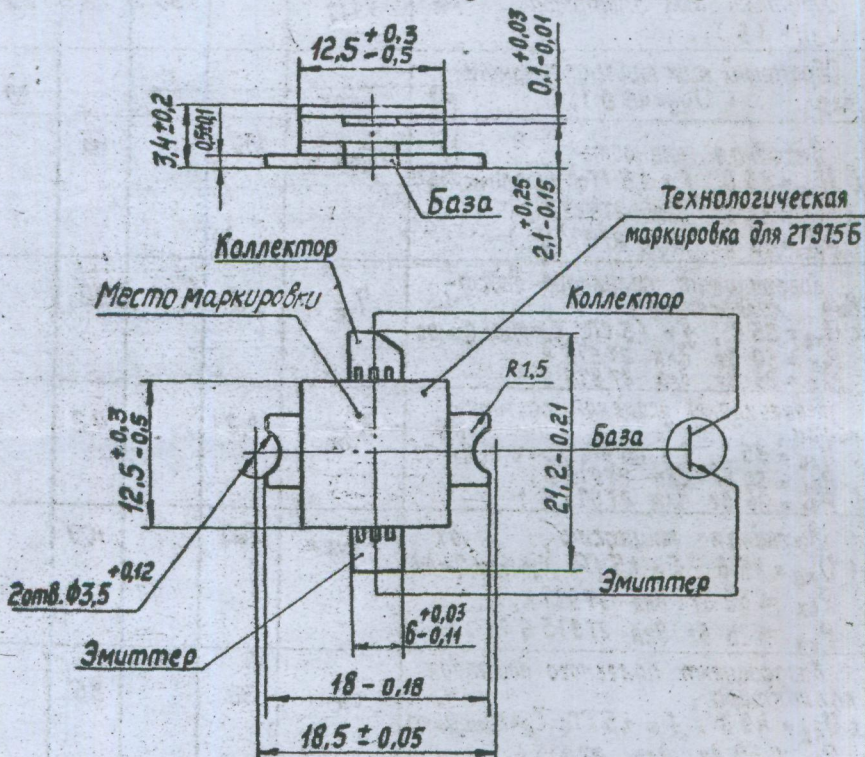
ЭТИКЕТКА

Транзистор 2Т975А, 2Т975Б
соответствует

техническим условиям

ОАО. 339. 299 ТУ

Чувствителен к статическому электричеству (Δ)



Масса не более 6 г

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	В 1000 шт. транзисторов (г)	В том числе на выводах	Толщина покрытия, мкм
Золото	47,56	Удельный расход на единицу длины вывода, (г/мм) 0,0007	3л 2,5
Серебро	91,90	—	—
Палладий	5,07	0,0001	пд 0,5

Основные электрические параметры при $t_{кор} = +25 \pm 10^\circ C$

Наименование параметра (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма			
		2Т975 А		2Т975 Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора, мА ($U_{кб} = 50 В$)	$I_{кб0}$		50		25
Обратный ток эмиттера, мА ($U_{эб} = 3 В$)	$I_{эб0}$		50		25
Обратный ток коллектор-эмит- тер ($U_{кэ} = 45 В$), мА	$I_{кэк}$		40		20
Выходная мощность, Вт ($U_{кб} = 35 В$, $f = 1,5 ГГц$, $t_n \leq 10 мкс$, $Q \geq 100$ $P_{вх} = 50 Вт$ для 2Т975 А, $P_{вх} = 25 Вт$ для 2Т975 Б)	$P_{вых. и}$	130		65	
Коэффициент полезного дейст- вия коллектора, % ($U_{кб} = 35 В$, $f = 1,5 ГГц$, $t_n \leq 10 мкс$, $Q \geq 100$ $P_{вх} = 50 Вт$ для 2Т975 А, $P_{вх} = 25 Вт$ для 2Т975 Б)	η_k	25		30	
Коэффициент усиления по мощ- ности, дБ ($U_{кб} = 35 В$, $f = 1,5 ГГц$, $t_n \leq 10 мкс$, $Q \geq 100$ $P_{вх} = 50 Вт$ для 2Т975 А, $P_{вх} = 25 Вт$ для 2Т975 Б)	$K_{ур}$	4,2		4,2	
Выходная мощность, Вт ($U_{кб} = 45 В$, $f = 1,5 ГГц$, $t_n \leq 10 мкс$, $Q \geq 100$ $P_{вх} \leq 50 Вт$ для 2Т975 А, $P_{вх} \leq 25 Вт$ для 2Т975 Б)	$P_{вых. и}$	200		100	
Коэффициент полезного действия коллектора, % ($U_{кб} = 45 В$, $f = 1,5 ГГц$, $t_n \leq 10 мкс$, $Q \geq 100$ $P_{вх} \leq 50 Вт$ для 2Т975 А, $P_{вх} \leq 25 Вт$ для 2Т975 Б)	η_k	30		35	
Коэффициент усиления по мощности, дБ ($U_{кб} = 45 В$, $f = 1,5 ГГц$, $t_n \leq 10 мкс$, $Q \geq 100$ $P_{вх} \leq 50 Вт$ для 2Т975 А, $P_{вх} \leq 25 Вт$ для 2Т975 Б)	$K_{ур}$	6		6	

Место для штампа
ОТК № 18 ОТК

Место для штампа
представителя заказчика